



ワイドギャップ半導体に基づく光・量子デバイスの最前線

◇日時: 2026年7月9日(木) 10:00~16:25
2026年7月10日(金) 10:00~16:25

◇場所: ウィンクあいち 1203会議室 (愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
+Zoomによるオンライン **ハイブリッド開催**

結晶工学分科会第165回研究会および応用電子物性分科会研究例会を、7月9日(木)・10日(金)の2日間にわたり開催いたします。本研究会では、GaN系レーザー・LED、UV LD、VCSEL、量子光源、光AIなど、ワイドギャップ半導体を基盤とした最先端の光・量子デバイス研究について議論いたします。産学の第一線の研究者による講演を通じて、分野横断的な知見共有と今後の研究展開を議論する機会といたします。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

7月9日(木) 結晶工学分科会第165回研究会

担当幹事: 船戸(京大)、谷川(名城大)、前田(東大)

1. 結晶工学分科会 幹事長 挨拶
2. 企画趣旨説明 担当幹事
3. GaN系ワット級青色PCSEL(仮題) 江本溪(スタンレー電気)
4. AlN/AlGaIn超格子を用いた深紫外発光デバイスの研究開発 江端一晃(NTT物性研)
11:45-13:00 休憩
5. 人為形成三次元構造によるInGaIn系RGBマイクロLEDの結晶成長集積 松田祥伸(京都大)
6. UV-B半導体レーザーの高効率化に向けたAlGaInヘテロ構造の結晶成長と物性制御 齋藤巧夢(名城大)
14:30-14:55 休憩
7. 量子コンピュータ用紫外レーザー光源の開発 平井誉主在(オキサイド)
8. 長共振器 VCSEL と光パラメータ制御 濱口達史(九州大)

7月10日(金) 応用電子物性分科会研究例会

担当幹事: 岩谷(名城大)、堀田(名大)、久保(名工大)

1. 応用電子物性分科会 幹事長 挨拶
2. GaAs LDを励起光源とした大出力Yb:YAGセラミクスレーザーの研究開発 関根尊史(浜松ホトニクス)
3. 単結晶AlN基板を用いたAlGaIn系深紫外LD 張梓懿(ULTEC)
11:40-13:00 休憩
4. 光無線給電の研究:IoT端末から移動体, 水中まで 宮本智之(東京科学大)
5. 薄膜LiNbO₃・窒化物半導体を用いた光AIプロセッサ開発 片山竜二(大阪大)
14:30-14:55 休憩
6. MoS₂/GaInヘテロ構造を用いたUTC-PDの研究開発 門脇拓也(日亜化学工業)
7. フレキシブルGaIn系μLED-ECOG神経インターフェースの開発 関口寛人(名城大)

■受付: 結晶工学分科会webページより事前登録をお願いいたします。 <https://annex.jsap.or.jp/kessho/event/kenkyu260709/>

■参加費(テキスト代・消費税込): 2日間通して参加いただけます。1日のみの参加でも同額です。

応用電子物性分科会会員もしくは結晶工学分科会会員 6,000円 分科会学生会員 2000円

応用物理学会会員(分科会会員でない場合) 15,000円 シニア会員 5,000円 一般 20,000円 学生 4,000円

応電分科会賛助会社、結晶分科会賛助会社の方は、分科会会員と同額とします。

■問合せ先: 久保 俊晴 (名工大)

E-mail: kubo.toshiharu@nitech.ac.jp

前田 拓也 (東大)

E-mail: tmaeda@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

白石/吉田 (応用物理学会 事務局) TEL: 03-3828-7723(直通) E-mail: divisions@jsap.or.jp

(スパム対策のため上記“@”は全角になっています。半角の“@”に置き換えて下さい。)